

广东省粤晶高科股份有限公司

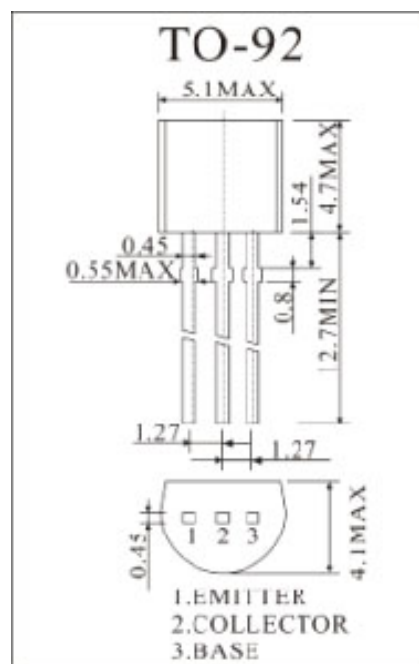
C380

—NPN silicon—

■■主要用途：高频放大等。

■■绝对最大额定值（Ta=25℃）

项 目	符 号	额定值	单 位
集电极—基极电压	V_{CBO}	35	V
集电极—发射极电压	V_{CEO}	30	V
发射极—基极电压	V_{EBO}	4	V
集电极电流	I_C	50	mA
集电极耗散功率	P_C	300	mW
结 温	T_J	150	℃
存储温度	T_{stg}	- 55~150	℃



■■电参数（Ta=25℃）

项 目	符 号	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
直流电流增益	h_{FE}	40		240		$V_{CE}=12\text{ V}$, $I_C=2\text{ mA}$
集电极-基极截止电流	I_{CBO}			0.1	$\mu\text{ A}$	$V_{CB}=35\text{ V}$, $I_E=0$
发射极-基极截止电流	I_{EBO}			0.1	$\mu\text{ A}$	$V_{EB}=4\text{ V}$, $I_C=0$
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	35			V	$I_C=0.1\text{ mA}$, $I_E=0$
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	30			V	$I_C=1\text{ mA}$, $I_B=0$
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	4			V	$I_E=0.1\text{ mA}$, $I_C=0$
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$			0.4	V	$I_C=10\text{ mA}$, $I_B=1\text{ mA}$
基极-发射极电压	V_{BE}			1.0	V	$I_C=10\text{ mA}$, $I_B=1\text{ mA}$
电流增益-带宽乘积	f_T	100	300		MHz	$I_C=1\text{ mA}$, $V_{CE}=10\text{ V}$
共基极输出电容	C_{ob}		2.0	3.2	PF	$V_{CB}=10\text{ V}$, $I_E=0$, $f=1\text{ MHz}$
功率增益	K_p	27	29	33	dB	$V_{CB}=6\text{ V}$, $I_E=-1\text{ mA}$, $f=10.7\text{ MHz}$

■■ h_{FE} 分档及其标识志

分档	R	O	Y
h_{FE}	40~80	70~140	120~240